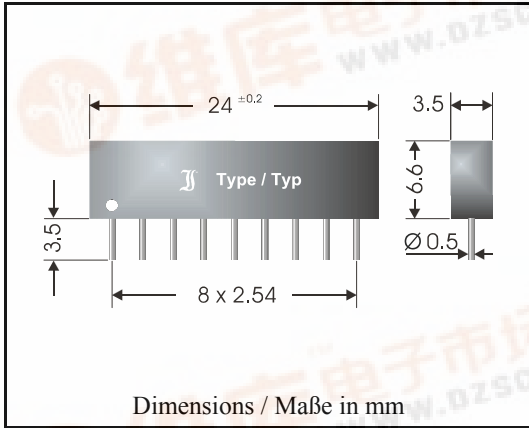
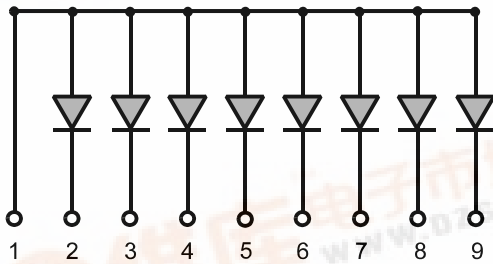


Small Diode Arrays

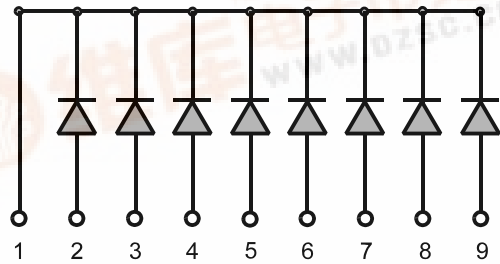
Dioden Sätze mit Allzweckdioden



Nominal power dissipation	200 mW
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	80 V
Periodische Spitzensperrspannung	
9 Pin-Plastic case	24 x 3.5 x 6.6 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden
"DA4148A": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden
"DA4148K": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 803 = DA 4148 K	80	80
DAP 803 = DA 4148 A	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, $T_A = 25^\circ C$
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

I_{FAV}	100 mA ¹⁾
I_{FAV}	25 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last, $T_U = 25^\circ C$
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

I_{FAV}	100 mA ¹⁾
I_{FAV}	25 mA ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ C$ I_{FSM} 500 mA
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen



¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	- 50...+150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	- 50...+150 °C

Characteristics		Kennwerte	
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	$V_F < 1.0\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	$I_R < 25\text{ nA}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA through/über}$ $I_R = 10\text{ mA to/auf } I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	$< 4\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	$< 85\text{ K/W}^1)$

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten